

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук**

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
ведущего научного сотрудника – заведующего лабораторией
в лаборатории Инфракрасной оптоэлектроники
Вакансия VAC_26684

Тематика исследований

Исследования и разработки в области физических основ переходных процессов и рекомбинации носителей заряда, а также излучательных процессов и фотоэлектрических явлений в наногетероструктурах на основе узкозонных полупроводников A^3B^5 ;

Исследование электронного транспорта, магнитотранспорта и оптических явлений, а также рекомбинационных и переходных процессов в узкозонных наногетероструктурах в системе GaSb-InAs, в том числе в сверхрешетках GaSb/InAs;

Разработка технологии создания наногетероструктур, в том числе с глубокими ямами, на основе узкозонных полупроводников A^3B^5 и исследование процессов излучательной рекомбинации и ударной ионизации в таких структурах.

Деятельность:

Осуществление научного руководства конкретными темами исследований согласно государственному заданию и планам НИР по утверждённым целевым программам, а также подготовка и подача заявок на новые проекты в рамках базового бюджетного и целевого финансирования; руководство работой сотрудников, выполняющих эти исследования, и обеспечение выполнения ими правил внутреннего распорядка в учреждении. Непосредственное участие в выполнении исследований: разработка методов решения наиболее сложных научных проблем; обоснование направлений новых исследований и разработок, предложений к программам и планам научно-исследовательских работ; организация разработки новых научных проектов; координация деятельности соисполнителей работ; обеспечение анализа и обобщения полученных результатов, предложение сферы их применения. Осуществление подготовки научных кадров, участие в повышении их квалификации, а также в подготовке специалистов с высшим образованием в соответствующей области (руководство дипломными и курсовыми работами).

Особенности трудовой деятельности: ведущий научный сотрудник – заведующий лабораторией Инфракрасной оптоэлектроники несет полную материальную ответственность за имущество, закрепленное за лабораторией, а также работает со сведениями, составляющими государственную тайну по ф. 3.

С целью обеспечения поддержания уровня исследований в лаборатории Инфракрасной оптоэлектроники на уровне, не ниже достигнутого в настоящее время, при оценке кандидатов комиссия будет исходить из следующих минимальных требований к квалификации кандидатов.

- Наличие ученой степени кандидата физико-математических наук
- Общее количество научных, конструкторских и технологических произведений: не менее 84.
- Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности: не менее 3.
- Число публикаций, индексируемых в российских и международных информационно-аналитических системах научного цитирования с 2000 г.: Scopus (шт.): не менее 37, Web of Science (шт.): не менее 36.

- Индекс Хирша по Scopus DB: не менее 7.
- Опыт научной работы: не менее 25 лет.
- Опыт научно-организаторской работы: не менее 5 лет.

За последние 5 лет руководство не менее чем 2 проектами в рамках ПФНИ Президиума РАН; не менее чем 1 договором НИОКР с научно-производственными организациями-заказчиками; 2 грантами отечественных и зарубежных научных фондов; подготовка не менее 3 научных кадров высшей квалификации (кандидаты наук, магистры).

К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы

- личный листок по учету кадров;
- копии документов о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания;
- сведения о научной (научно-организационной) работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса;
- характеристика с последнего места работы.

Документы следует направлять по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 26, заместителю директора ФТИ им. А.Ф. Иоффе А.Б. Подласкину, телефон для справок: (812)2927196.

Настоящие требования к кандидатам и перечень необходимых документов опубликованы на веб-сайте ФТИ им. А.Ф. Иоффе (<http://www.ioffe.ru>).